

粹取之上,來確定一種離子能量的分佈函數(IEDF) 探 應刪除申請專利範圍第1至了項未具有本案特徵之裝置部份 針 如附 來粹取當時的電壓 件) ,在其申請專利範圍的第1項中就已揭示。本案的特徵在處理方法 然後將粹取 到 的數據 ,交由 ,用以改善電漿處理系統的性能, 控制系統來控制 如專利公告第308778號 及分佈函數的 故本案

正本:東京威力科創有限公司(代理人:林志剛 先生)

副本:

局長祭

授權單位主管決行依照分層負責規定

生

第二頁



(11)公告網號:308778

(44)中華民國86年(1997)06月21日

發明

全 4 頁

(51) Int · C | 6: HO5H1/24

(54)名

稍:電漿探針偵測之取模器

(21)申 請 家 號:85101704

(22)申請日期:中華民國85年(1996)02月12日

(72) 後 明 人: 安東尼・恭亞尼

美國

(71)中 計 人主 雅美公司伊恩艾分公司

美國

(74)代 理 人: 黄香 先生

1

2

## [57] 申請專利範圍:

1. 一種電漿裝置,在該電漿裝置之中, 一個射頻電源產生器以一預定的頻率產 生射頻電波,前述的電波經由一射頻匹 配網路被輸送到一電漿室的電源輸入口 , 在該電漿室內部, 前述的電波產生出 電漿,以及,在該電漿裝置之中,偵測 裝置在前述電漿室的入口處對該射頻電 波,採取其樣本,以判定被施加到前述 電漿室的射頻電源之量測值;其特徵在 於:前述偵測裝置包含有取樣裝置,該 取樣裝置以預定的取樣速率取樣前述射 **頻電波的振幅**,並連結一合成電路,結 合所取樣的振幅,以預定的疊合頻率, 產生疊合波形,該疊合頻率明顯低於前 述產生射頻電波的預定頻率,又,該**取** 樣速率低於前述產生射頻電波的預定頻 率。

2. 如申請專利範圍第1項所述之裝置,更 進一步的特徵在於:前述的射頻電源產 生器以前述的預定頻率F產生前述的射 頻電波,前述預定的叠合頻率被選擇為 fa,且前述的取樣速率 fs 被選擇為 fs=F/N+/-fa/N

其中, N是一個大於1的整數。

- 5. 3. 如申請專利範圍第 2 項所述的裝置, 更進一步的特徵在於: 前述預定頻率 F 為 13.56MHz, 前述疊合頻率 fs 約為 50KHz 至 250KHz 的大小。
  - 4. 如申請專利範圍第2項所述的裝置,更 進一步的特徵在於:前述的整數N至少 是5。
  - 5. 如申請專利範圍第1項所述的裝置, 更進一步的特徵在於:前述取樣裝置包含:
- 一個取樣時鐘,該時鐘以前述的取樣速率操作,
  - 一個第一高速取樣與保持裝置,該裝置 係由前述的取樣時鐘操作,以取樣前述 射頻電波的電壓,
  - 一個第二高速取樣與保持裝置,該裝置

10.

3

係由前述的取樣時鐘操作,以取樣前述 射頻電波的電流,以及

前述的合成裝置包括有產生叠合電壓波 形和產生疊合電流波形的裝置。

- 6. 如申請專利範圍第 5 項所述的裝置,更 進一步的特徵在於:前述第一和第二取 樣和保持裝置,分別包含一個 A/D 轉 換器,該轉換器能夠產生至少 12 位元 寬度的數位樣本。
- 7. 如申請專利範圍第6項所述的裝置,更 進一步的特徵在於:前述的第一和第二 取樣與保持裝置對於相伴生的電壓和電 流波形同時進行取樣。
- 8. 如申請專利範圍第6項所述的裝置,更進一步的特徵在於:前述的第一和第二

數位門鎖機構分別聯結於前述的第一和 第二取樣與保持裝置和一數位訊號處理 器的個別輸入口之間。

## 圖示簡單說明:

5. 圖一係射頻電漿裝置的方塊圖,該 射頻電漿裝置包含有根據本發明較佳實 施例的射頻電源產生器、阻抗匹配網路 、電漿室、和射頻電源探針。

圖二係本發明之探針實施例的交接 點取樣部份的簡化示意圖。

圖三 A 至圖三 C 係解釋本發明實施例裡施加的射頻電源波形、取樣脈衝、和所取得樣本的振幅數值。

圖四係本實施例產生的重疊波形。

15.

10.











